

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成 24 年 5 月 31 日 (2012.5.31)

【公開番号】特開 2009-280909 (P2009-280909A)

【公開日】平成 21 年 12 月 3 日 (2009.12.3)

【年通号数】公開・登録公報 2009-048

【出願番号】特願 2009-103940 (P2009-103940)

【国際特許分類】

C 2 3 C 14/04 (2006.01)

C 2 3 C 14/28 (2006.01)

C 2 3 C 14/12 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 23/532 (2006.01)

H 0 1 L 21/768 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 5 B 33/02 (2006.01)

H 0 1 L 21/288 (2006.01)

【 F I 】

C 2 3 C 14/04 C

C 2 3 C 14/28

C 2 3 C 14/12

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

H 0 1 L 21/88 M

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

H 0 5 B 33/02

H 0 1 L 21/288 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 4 月 9 日 (2012.4.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

一方の面に、光吸収層と、前記光吸収層に接して形成された材料層と、を有する第 1 の基板を用い、

前記第 1 の基板の前記材料層が形成された面と、第 2 の基板の被成膜面とを対向させ、
前記第 1 の基板の他方の面側から周波数 10 MHz 以上、パルス幅 100 fs 以上 10 ns 以下のレーザ光を照射し、前記光吸収層と重なる位置にある前記材料層の一部を選択的に加熱し、前記材料層の一部を前記第 2 の基板の被成膜面に成膜する成膜方法において、式 (1) または式 (2) を満たす条件で成膜することを特徴とする成膜方法。

【数 1】

$$d \geq \frac{\alpha t c}{2n} \quad \dots (1)$$

(式(1)において、 d は第1の基板の厚さ[m]、 n は第1の基板の屈折率、 c は光速[m/s]、 t はレーザー光のパルス幅[s]、 α は0.2以上の実数を表す。)

【数 2】

$$d \geq \frac{10nW}{NA} \quad \dots (2)$$

(式(2)において、 d は第1の基板の厚さ[m]、 n は第1の基板の屈折率、 W は被照射面におけるレーザービームの幅[m]、 NA はレーザービームを成形するレンズの NA を表す。)

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記レーザー光は線状または矩形状に成形されていることを特徴とする成膜方法。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記光吸収層は、金属窒化物を含むことを特徴とする成膜方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかにおいて、

前記材料層は有機化合物からなることを特徴とする成膜方法。

【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかに記載の成膜方法を用い、

前記材料層の一部を、前記第2の基板の被成膜面上に形成されている第1の電極上に成膜することを特徴とする発光装置の作製方法。